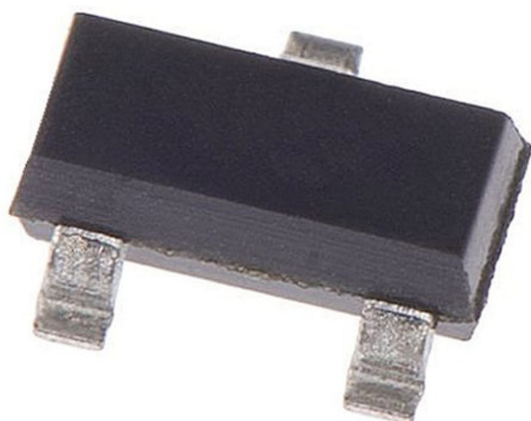


Transistor RQ5H020SPTL MOSFET-P unipolaire -45V -2A -8A 1W 0,13ohm TSMT3

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVRQ5H020
-------	------------



Transistor RQ5H020SPTL MOSFET-P unipolaire -45V -2A -8A 1W 0,13ohm TSMT3

Transistor RQ5H020SPTL MOSFET-P unipolaire -45V -2A -8A 1W 0,13ohm TSMT3

Type de canal: Canal P
Polarité transistor: Canal P
Courant de drain Id: 2A
Tension Vds max.: 45V
Résistance Drain-Source à l'état-ON: 0.13ohm
Résistance Rds(on): 0.13ohm
Tension de test Rds(on): 10V
Montage transistor: Montage en surface
Tension de seuil Vgs Max: 3V
Dissipation de puissance Pd: 1W
Type de boîtier de transistor: TSMT
Nombre de broches: 3Broche(s)
Dissipation de puissance: 1W
Température de fonctionnement max.: 150°C

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles